



2026年2月10日

各 位

会 社 名 J X 金属株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 陽一
(コード: 5016、東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部 米 山 学
開示担当課長
(TEL. 03-6433-6088)

結晶材料の増産に向けた設備投資（固定資産の取得）の追加に関するお知らせ

J X 金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、本日、光通信分野を中心に需要が急増している結晶材料であるインジウムリン（以下「InP」）基板の生産能力をさらに強化するため、設備投資を実施することを決定いたしましたのでお知らせします。

本設備投資は、2025年7月23日付「結晶材料の増産に向けた設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ（以下「2025年7月23日付公表文※1」）」および2025年10月8日付「結晶材料の増産に向けた設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ（以下「2025年10月8日付公表文※2」）」にて公表したInP基板設備増強に続くもので、従来品の能力増強に加え、基板大型化のニーズにも対応しようとするものです。

1. 理由

近年、生成AIの急速な進化を背景に、ハイパースケールデータセンターの建設が世界的に加速しており、今後も市場のさらなる拡大が見込まれています。これに伴い、データセンターにおけるデータ伝送量は急増しており、それに比例して消費電力も増加しています。こうした状況を受け、従来の電気信号による通信に代わり、より高速かつ大容量のデータ伝送が可能で、消費電力の低減にも寄与する光通信への移行が加速しています。

この光通信を支える重要な材料の一つがInPです。InPは、電気信号と光信号を相互に変換できる特性を持ち、光通信の受発光素子をはじめ、ウェアラブル端末における近接センサや産業用イメージセンサなど、幅広い分野で用いられる高機能デバイスの製造に不可欠な先端材料です。特に、前述の背景を踏まえ、データセンター間の通信のみならず、データセンター内のラック間・ラック内といった近距離向けにも光通信の適用が拡大しており、光トランシーバーの需要が急速に高まっています。さらに、次世代の情報通信基盤技術として開発が進められている光電融合技術においてもInPの採用が見込まれており、ボード内、チップ間、さらにはチップ内での活用が期待されています。

当社では、この需要拡大に対応すべく、昨年7月に設備投資を決定し、昨年10月に追加の設備投資を決定いたしましたが、さらに、生成AIの進化が今後も継続すると予想される中、InP基板の中長期的な需要急伸、特に今後の光電融合技術の進化・普及を支えるための基板大型化のニーズにも対応できる生産体制の構築が急務であると判断し、追加の設備投資を決定いたしました。

2. 設備投資の概要

(1) 内容

磯原工場（茨城県北茨城市）に InP 基板の製造設備一式を増強

(2) 投資額

約 200 億円

(3) 生産能力

2030 年時点で 2025 年比約 3 倍（2025 年 7 月 23 日付公表文、2025 年 10 月 8 日付公表文の設備投資増加分と合わせて）

(4) 稼働開始

2027 年度より段階的に稼働（予定）

3. 今後の見通し

2026 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。

以 上

＜参考資料＞

※1 2025 年 7 月 23 日付公表文

[「結晶材料の増産に向けた設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ」（PDF）](#)

※2 2025 年 10 月 8 日付公表文

[「結晶材料の増産に向けた設備投資（固定資産の取得）の追加に関するお知らせ」（PDF）](#)



InP 基板